50.05.0139 0140

ITT Standard 8027 Zürich, Postfach Brandschenkestrasse 178 Telefon 051 36 42 55

Zweifach NF-Verstürker TBA 931

Zusammenfassung

Für die Anwendung im NF-Sektor wurde von Intermetall ein monolithisch integrierter ZweisachVerstärker TBA 931 in Bipolartechnik entwickelt.
Durch günstiges Rauschverhalten, geringe Abhängigkeit der Verstärkung von Versorgungsspannung und Umgebungstemperatur, sowie Kurzschlussfestigkeit des Ausgangs ist der TBA 931 sehr gut für die Anwendung in hochwertigen Hi-Fi-Stereogeräten, besonders Tonbandgeräten und Plattenspielern mit magnetischem Tonabnehmer, geeignet. Die Spannungsversorgung kann sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch erfolgen. Der relativ geringe Auswand an externen Bauelementen macht den TBA 931 auch von der Kostenseite für Neuentwicklungen interessant.

- 1. Einleitung
- 2. 1. Eigenschaften und elektrische Daten
- 2. 2. Schaltungsbeschreibung, Verstärker und Schutzschaltung
- 2. 3. Kristall, Auslegung und Technologie
- 3. 1. Prinzipschaltung TBA 931 als NF-Verstärker
- 3. 2. Praktische Anwendung, RIAA-Schaltung
- 3.3. Zusatz von Studer -
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Schrifttum: 1) Hans R. Camenzind
 Circuit Design for Integrated
 Electronics
 - 2) H. Mielke, R. Sydow Stereo-Entzerrer-Verstärker mit Si-Planar-Transistoren für magnetische Tonnbnehmer

6. Zeichnungen, Foto

Tab. 1 Daten

Bild 1 Kristallfoto

" 2 Innenschaltung

5 Schutzschaltung

4 Prinzipschaltung als NF-Verstärker

" 5 Frequenzgang durch Gegenkopplung

" 6 RIAA-Schaltung

7 RIAA-Kurve

8 maximale Ausgangs-Spannung

Zweifach NF-Verstärker TBA 931

1. Einleitung

Die ständig weiterschreitende Entwicklung von NF-Verstärkern, insbesondere in der Tonbandgeräte-, Heimstudio- und Stereo-Technik, führt zu der Forderung nach qualitativ hochwertigen und räumlich möglichst kleinen Bauelementen.
Ein neues Bauteil, das diese Forderungen erfüllt, ist der monolithisch integrierte Zweifach-NF-Verstärker TBA 931 von Intermetall.

2. 1. Eigenschaften und elektrische Daten

Mit der integrierten Schaltung TBA 931 sind optimale Rauscheigenschaften, geringe Abhängigkeit der
Verstärkung von der Versorgungsspannung, hohe
Gleichtaktunterdrückung, hoher Ausgangsspannungshub
bei kleinem Ausgangswiderstand und gute Werte der
Übersprechdämpfung realisiert. Eine eingebaute
Sicherheitsschaltung macht die Ausgangsstufe kurzschlussfest.

Tab. 1 zeigt die wichtigsten Kenn- u. Grenzwerte des TBA 931. Der TBA 931 ist im TD 116 Dual-in-Line Kunststoffgehäuse aufgebaut. Er wird in drei Gruppen, nach dem Rauschmass selektiert, geliefert.

TBA 931-1 F \(\) 6 dB

TBA 931-2 F \(\) 3 dB

TBA 931-3 F \(\) 1,5 dB

2. 2. Schaltungsbeschreibung, Verstärker und Schutzschaltung

Bild 2 zeigt die Innenschaltung des TBA 931.

Die beiden Verstärker sind symmetrisch zur

Diodenkette angeordnet. Diese Art der Anordnung ergibt hoh: Werte der Übersprechdämpfung
über den gesamten Frequenzbereich. Jeder Verstärker hat einen symmetrischen Eingang, einen
asymmetrischen Ausgang und besteht aus drei
spannungsverstärkenden Stufen und einer Gegentakt-Ausgangsstufe mit einer Schutzschaltung
zur Ausgangsstrombegrenzung.

Der Eingangsdifferenzverstärker besteht aus den Transistoren T1 und T2 und der Konstantstromquelle T3, der Basisstrom für den Transistor T 3 wird der gemeinsamen Diodenkette entnommen. Der Kollektorstrom der Transistoren T1 und T2 ist so gewählt, dass sich in Verbindung mit der speziellen Technologie sehr günstige Rauschwerte ergeben. Das verstärkte Signal wird symmetrisch den Transistoren T4 und T5 eines zweiten Differenzverstärkers zugeführt. Diese Transistoren werden aus der Konstantstromquelle T6, die ihren Basisstrom eben-

falls aus der gemeinsamen Diodenkette erhält, gespeist. Der Einsatz von Konstantstromquellen an
Stelle von hochohmigen Emitterwiderständen in den
Differenzverstärkern, ermöglicht eine hohe Gleichtaktunterdrückung.

Am Widerstand R6 wird das weiter verstärkte Signal asymmetrisch abgenommen und der aus den Transistoren T7 und T8 gebildeten Lin-Kombination zugeführt.

Die Wahl dieser Schaltungsanordnung hat technologische Gründe. PNP-Transistoren werden bei der angewandten Diffusionstechnik im Gegensatz zu den vertikalen NPN-Transistoren lateral ausgelegt. Diese Technik hat zur Folge, daß die PNP-Transistoren kleinere Stromverstärkungswerte haben. Diesen Nachteil gleicht man mit der Zusammenschaltung von PNP- und NPN-Transistoren zur Lin-Schaltung aus. Vereinfacht dargestellt dient der PNP-Transistor nur der Pegelumsetzung, während die Stromverstärkung im NPN-Transistor erfolgt.

In dieser Lin-Kombination erfolgt die Pegelumsetzung, eine weitere Spannungsverstärkung und das Anpassen an die Endstufe.

Die Endstufe besteht aus den Transistoren T9,
Tlo, Tll und ist in Quasi-Komplementär-Technik
ausgeführt. Die Lin-Kombination aus den Transistoren Tlo und Tll wirkt hier ebenfalls wie ein
PNP-Transistor. Die Dioden D7 und D8 dienen der
Arbeitspunkteinstellung für den AB-Betrieb der
Endstufe. Diese Betriebsart vermeidet störende
Übernahmeverzerrungen, und die Endstufe ist über

den gesamten Arbeitsbereich weitgehend linear. Insgesamt ergibt sich so ein sehr kleiner Klirrfaktor, selbst beim rein theoretischen Betrieb der integrierten Schaltung ohne Gegenkopplung. Zum Schutz der Endstufe dient der Transistor Tl2. Beim Kurzschluß des Ausgangs, der sowohl nach +U_R als auch nach $-\mathbf{U}_{\mathbf{R}}$ möglich ist, wird die Endstufe ausreichend vor Überlastung geschützt. Die Schutzschaltung zeigt Bild 3. Erfolgt ein Kurzschluß nach $-U_{R}$, so steigt durch den erhöhten Ausgangsstrom die Spannung am Widerstand Rlo so weit an, bis der Transistor T12 leitend wird. Über den Transistor Tl2 fließt nun so viel Kollektorstrom vom Transistor T7 direkt zum Ausgang, daß der Basisstrom der Transistoren T8 und T9 gerade so groß ist, um den Emitter- und damit Ausgangsstrom durch den Transistor T9 nicht über den zulässigen Wert ansteigen zu lassen. Beim Kurzschluß des Ausgangs nach +U_R wird die Basis-Kollektor-Strekke des Schutztransistors T12 leitend. Der Transistor T8 wird weiter aufgesteuert und läßt den Strom über die Dioden D7, D8 und den Widerstand R9 ansteigen. Damit steigt das Potential an der Basis des Transistors Tlo in Richtung $+U_{\rm R}$ und begrenzt damit den Basisstrom des Transistors Tll und folglich den Ausgangsstrom auf den zulässigen Wert. Da die Arbeitspunkte der Schaltung durch Diodenspannungen bestimmt und die Differenzverstärkerstufen aus Konstantstromquellen gespeist werden, ist die Schaltung gegenüber Schwankungen der Versorgunsspannung und Temperatureinflüssen weitgehend unempfindlich und die Verstärkung über einen weiten Bereich konstant.

2. 3. Kristall, Auslegung und Technologie

Bild l zeigt eine Aufnahme des Kristalls, auf der der symmetrische Aufbau der Schaltung zu erkennen ist. Die Kristallgrösse beträgt 1,65 mm x 1,7 mm. Auffallend sind die in Zirkulargeometrie ausgelegten Eingangsstufen am unteren Bildrand und die grossflächigen Ausgangstransistoren oben. Die Forderung nach guten Rauscheigenschaften fordert ausser der speziellen Geometrie der Eingangstransistoren eine besondere Diffusionstechnik.

3. 1. Prinzipschaltung, TEA 931 als NF-Verstärker Bild 4 zeigt die Prinzipschaltung für die Anwendung des TBA 931 als NF-Verstärker. Die Stromversorgung erfolgt in diesem Fall über ein Plus-Minus-Netzteil mit geerdetem Mittelpunkt. Diese Schaltungsart hat den Vorteil, dass der Steuergenerator einseitig mit Masse verbunden sein kann, BasisspannungsteilerWiderstände und der Koppel-Hondensator entfallen. Eine Frequenzkompensation kann wie im Bild 4 gezeigt (loading compensation), oder auch wie gestrichelt ungezeichnet (feedback compensation) erfolgen. Für die Spannungsverstärkung V einer solchen Schaltung gilt (Frequenzkompensation nicht

$$v \approx \frac{R_{\rm H}}{R_{\rm l}} \ ,$$

berücksichtigt):

für die praktioche Anwendung ist der gesamte Verotärkungsbereich von V= 1 bis Vo nutzbar. Der Frequenzgäng der Gesamtschaltung ist beliebig einzustellen. Das kann mit einem Kondensator bis hin zu einem komplexen Netzwerk erfolgen. Wichtig ist, dass stets ein Gleichstromweg vom Ausgang zum – Eingang des Verstärkers, zum Einstellen des Gleichstrom – Arbeitspunktes vorhanden ist. Die prinzipielle Funktion zeigt Bild 5.

3. 2. Praktische Anwendung, RIAA-Schaltung

Bei hochwertigen magnetischen Tonabnehmern muss die Schallplatten-Schneidkenulinie entzerrt werden. Durch Addieren der Schneid- und Entzerrerkennlinie, die spiegelbildlich verlaufen, wird ein linearer Frequenzgang erreicht. Der Frequenzgang ist durch die RIAA-Norm festgelegt und entspricht der DIN 45546 und DIN 45547²). Im Bild 6 ist ein praktischer Anwendungsfall gezeigt. Das Beeinflussen des Frequenzganges erfolgt hier mit Hilfe der Widerstände R2, R3 und den Kondensatoren C2, C3. Der resultierende Frequenzgang entspricht der RIAA-Entzerrerkurve und ist im Bild 7 dargestellt. Die Kurve zeigt die Verstärkung V als Funktion der Frequenz. Für die Frequenz nahe Null ist die Verstärkung durch das Verhältnis der Widerstände RN/Rl bestimmt. Mit steigender Frequenz ist zunächst die Impedanz von R3 und C2 für die Gegenkopplung wirksam. Im Bereich um 1 kHz bestimmt die Impadanz von C2 in Serie mit der Impedanz der Parallelschaltung C3, R3 die Verstärkung. Mit weiter steigender Frquenz ist hauptsächlich die Impedanz von C3, R3 für den Grad der Gegenkopplung wirksam. Die Impedanz von C3, R2, C2 bestimmt bei hohen Frequenzen die Verstärkung.

In der Schaltung nach Bild 6 wird mit TBA 931-3 ein Störabstand gegenüber dem Eigenrauschen, be-

zogen auf eine Eingangsspannung von U_E = 2 mV, von 63 dB erreicht. Die maximale Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Frequenz in der Schaltunach Bild 6 zeigt Bild 8.

3.3. Zusatz von Studer

4. Schlußbetrachtung

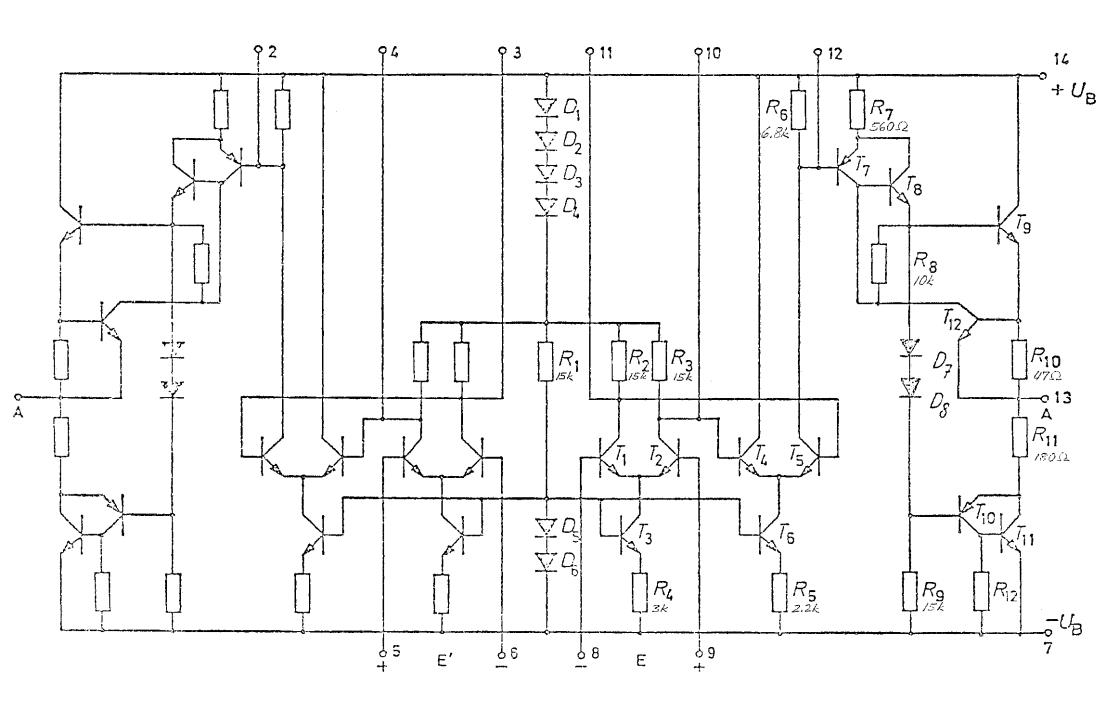
Die vorstehende Beschreibung zeigt die günstigen Eigenschaften und die einfache Anwendungsmöglichkeit der integrierten Schaltung TBA 931. Die Anwendung ist jedoch nicht auf den Niederfrequenz-Sektor beschränkt. Der Einsatz kann auch in anderen Elektronikbereichen erfolgen, wie z.B. für Steuer- und Regelschaltungen (stabilisierte Netzgeräte, Relaistreiber, Anzeigeverstärker usw.).

Kennwerte

Versorgungsspannung	\mathtt{U}_{B}	24	V
Stromaufnahme (ohne Aussteuerung)	I_{B}	8	$m\Lambda$
Leerlaufverstürkung	ν̈́ο	> 76	đВ
Grenzfrequenz	f _{3dB}	> 150	kHz
Eingangs-Widerstand	$\mathtt{r}_{\mathtt{E}}$	50	kΩ
Ausgangs-Widerstand	$\mathtt{r}_\mathtt{A}$	200	Ω
Übersprechdämpfung	Lii	60	dВ
Ausgangsspannung	U _{Ass}	16	V
Klirrfaktor (V= 40dB, $R_L = lk\Omega$	K	< o,]	15%

Grenzwerte

Versorgungsspannung	${\tt v}_{\tt B}$	25 V
Gleichtakt-Eingangs-Spannung	${f u}_{f E}^-$	-U _B +U _B
Differenz-Eingangs-Spannung	$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$	+ 6 V
Umgebungstemperatur-Bereich	$\mathtt{T}_{\mathtt{U}}^{-}$	o70°C



DUAL OPERATIONAL AMPLIFTER

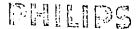
The TDA 931 is a monolithic integrated circuit, consisting of two indentical amplifiers. It is specially suitable for audio applications (stereo pre-amplifier) and as industral dual operational amplifier.

Special features are:

- very low noise figure
- low distortion
- continuous short circuit protection
- no latch up
- large output voltage swing
- usable as unity gain amplifier

QUICK REFE	CRENCE DATA					
Supply voltage	Vs	nom,		<u>†</u> 12 V		
Voltage gain	${ t G}_{ extsf{V}}$	typ.		15000		
Open loop frequency response	33	min.		150 KHz		
	version	1	2	3		
Broadband noise figure		6	3	1,5	dБ	
Output noise voltage (RTAA)		400	250	125	μV	rms

Package outline 14 lead plastic dual in-line (type A) Sec page.



Voltages				
Positive supply voltage	$v_{\mathbf{p}}$	max.	13 18	٧
Negative supply voltage	$-v_R$	max. /	13 18	V
Differencial input voltages	V ₅₋₆ } V ₈₋₉ }	max.	<u>+</u> 5	V
Common mode input voltage 1)	V _i	.xsm	±15	ν
Power dissipation	Ptot	max,	400	mM
Output short circuit duration	2) t	max.	60	
Temperatures				
Operating ambient temperature	r_{amb}	0 to 4-7	0	ОС
Storage temperature	T _{stg}	-55 to 1	25	ОС

¹⁾ For supply voltages less than \pm 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

²⁾ For one amplifier if short circuited to either supply or for both amplifiers together if short circuited to ground.

CHARACTERISTICS (each amplifier) at $v_{\rm p}\approx 12$	v; -v _N =	12 V; Tranb = 2	5 ^o c
Large signal voltage pain; (Vo = 2 5V)	G_{V}	> 61500	
		typ. 151000	
		< 501000	
Input offset voltage; Rs < 200 5_	Vico	typ. 1,0	mV
		< 6,0	raV
Input bias current	Ii	tур. 300	nΑ
		< 1000	nΛ
Input offset current	Iio	typ. 100	ıιΛ
		< 500	nΑ
Common mode rejection ratio; R _S <10KΩ	CMRR	> 70	dB
		typ. 100	dБ
Input voltage range	$v_{\mathtt{i}}$	typ. ± 9,0	V
Supply voltage rejection ratio; R _S <10KΩ	SVRR	typ. 50	μV/V
Peak output voltage swing at $R_L = 1 \text{K}\Omega$	v _{OM}	> 8	V
(fig. 1)			
Power dissipation; (both amplifiers)			
$V_{o} = 0$, $I_{o} = 0$	P_{tot}		V_{IM}
		< 240	пу√
Slew rate (unity-gain)		typ, 1	V/µs
Broadband noise figure (fig. 1)			
($R_S = 10 \text{ K}\Omega$; $B = 10 \text{ Hz to } 10 \text{ kHz}$)	TBA 931/	1 < 6	dВ
	TBA 931/	2 < 3	d B
	TBA 931/	3 < 1,5	đВ
Output noise voltages (fig. 2)			
(equalization RIAA; E = 10 Hz to 10 kHz)	TBA 931/	1 < 400	μV
	TBA 931/	2 < 250	μV
	TBA 931/	3 < 125	J1V

Channel separation (Lig. 3)

$$(B = 100 \text{ Hz to } 20 \text{ kHz})$$
 typ. 70 dB

Distortion

(gain 60 dB,
$$V_0 = 5 V_{rms}$$
, 1 kHz) < 1,5 %

Fig. 1

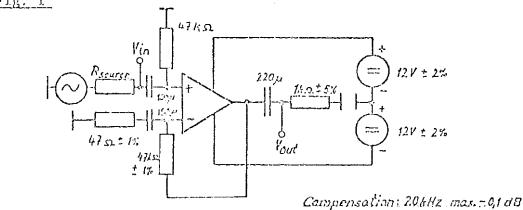


Fig. 2

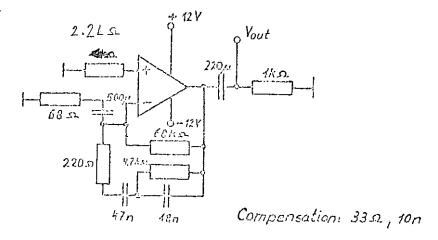
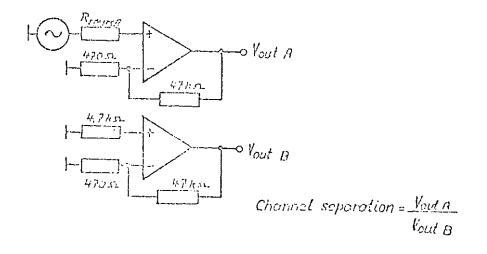


Fig. 3



CIRCUIT DIAGRAM

